

УДК 54-162

<https://doi.org/10.37827/ntsh.chem.2023.73.045>

Орисія БЕРЕЗНІОК, Олександр СМІТЮХ, Людмила ПІСКАЧ

СИСТЕМА $\text{Cu}_2\text{S} - \text{Sb}_2\text{S}_3 - \text{SnS}_2$

Волинський національний університет імені Лесі Українки,
проспект Волі, 13, 43025 Луцьк, Україна
e-mail: smitukh.oleksandr@vnu.edu.ua

За результатами рентгеноструктурного та диференційного аналізу побудовано сім політермічних перерізів, ізотермічний переріз і проекцію поверхні ліквідусу квазіпотрійної системи $\text{Cu}_2\text{S} - \text{Sb}_2\text{S}_3 - \text{SnS}_2$. Взаємодії у системі досить складні через інконгруентний тип утворення сполук Sb_2SnS_5 , $\text{Cu}_2\text{Sn}_4\text{S}_9$ і $\text{Cu}_4\text{Sn}_4\text{S}_4$ і утворення твердих розчинів α , β , γ , δ , ϵ , ζ , η на основі Cu_2S , Sb_2S_3 , SnS_2 , Cu_3SbS_3 , $\text{Cu}_4\text{Sn}_4\text{S}_4$, Cu_2SnS_3 , $\text{Cu}_2\text{Sn}_4\text{S}_9$, відповідно. Три політермічних перерізи цієї системи: $\text{Cu}_3\text{SbS}_3 - \text{Cu}_2\text{SnS}_3$, $\text{Cu}_3\text{SbS}_2 - \text{Cu}_2\text{SnS}_3$, $\text{Sb}_2\text{S}_3 - \text{Cu}_2\text{SnS}_3$ є квазібінарними та евтектичного типу. Перерізи $\text{Cu}_3\text{SbS}_3 - \text{Cu}_4\text{Sn}_4\text{S}_4$, $\text{Sb}_2\text{S}_3 - \text{Cu}_2\text{Sn}_4\text{S}_9$ і $\text{Sb}_2\text{SnS}_5 - \text{Cu}_2\text{Sn}_4\text{S}_9$ – квазібінарні лише в підсолідусній області. Побудований ізотермічний переріз за 500 характеризується значними твердими розчинами на основі сполук $\text{Cu}_3\text{SbS}_3 (>10 \text{ мол. \%})$ та $\text{Cu}_2\text{SnS}_3 (-7-8 \text{ мол. \%})$. Між бінарними та тернарними сполуками обмежуючих перерізів виявлено п'ятьнацять двофазових рівноваг, які розділяють площину концентраційного трикутника на сім трифазових полів: $\alpha - \delta - \epsilon$, $\delta - \epsilon - \zeta$, $\text{CuSbS}_2 - \delta - \zeta$, $\beta - \text{CuSbS}_2 - \zeta$, $\beta - \zeta - \eta$, $\beta - \eta - \text{Sb}_2\text{SnS}_5$, $\text{Sb}_2\text{SnS}_5 - \eta - \gamma$. Проекція поверхні ліквідусу на концентраційний трикутник отирається двадцять однією моноваріантною кривою, п'ятьма подвійними та дев'ятьма потрійними нонваріантними процесами (три перитектичні та шість евтектичних).

Ключові слова: квазібінарна система, евтектика, перитектика, тверді розчини.

Вступ

Багатокомпонентні матеріали на основі сполук сульфуровмісних систем володіють різноманітними властивостями, зокрема такими як фотокatalітична та електрохімічна активності. Їхні характеристики визначаються в певній мірі властивостями вихідних обмежуючих фаз. Багатокомпонентна система $\text{Cu} - \text{Sb} - \text{Sn} - \text{S}$ є цікавим об'єктом, оскільки на обмежуючих сторонах її квазіпотрійної системи $\text{Cu}_2\text{S} - \text{Sb}_2\text{S}_3 - \text{SnS}_2$ утворюються ізоструктурні фази, що може свідчити про існування твердих розчинів на основі відповідних сполук. Автори [1] з'ясували те, що система $\text{Cu} - \text{S}$ містить ряд фаз, які відрізняються між собою S-атомним укладанням (гексагональна та кубічна компірка). Купрум(I) сульфід використовують у конденсаторах великої ємності, в пристроях пам'яті – мемристорах, завдяки тому, що її β -модифікація володіє суперіонною електропровідністю [2]. Cu_2S є перспективним термоелектричним і суперіонним матеріалом [3]. У системі $\text{Sb} - \text{S}$ [4] утворюється одна фаза Sb_2S_3 . Тонкі плівки на основі цієї сполуки є прямоузонним напівпровідниковим матеріалом [5]. Також ці плівки є перспективним поглиначем світла для застосування в сонячних елементах завдяки відповідній ширині

забороненої зони, високому коефіцієнту поглинання та не токсичності [6]. В системі Sn – S, згідно з [7], виявлено чотири сполуки, SnS₂ кристалізується в структурному типі CdI₂ і становить інтерес як матеріал у тонкоплівкових сонячних елементах (наприклад, для заміни токсичного CdS) [8]. В системі Cu₂S – Sb₂S₃ відомо про утворення трьох сполук: Cu₃SbS₃, CuSbS₂ [9] та CuSb₅S₈ [10]. Фаза Cu₃SbS₃ – це термоелектричний сульфід (коефіцієнта Зеебека становить 0,57 за температури 623 К [11]) з сильною вібраційною ангармонічністю, що характеризується неподіленою парою електронів на Sb-позиції і трикоординованими іонами Cu, що демонструють велику амплітуду коливань [12]; на основі сполуки CuSbS₂ отримано тонкі плівки, які володіють добротними оптичними та електричними властивостями [13]. В системі Cu₂S – SnS₂ [14] існує три сполуки Cu₄SnS₄, Cu₂SnS₃ та Cu₂Sn₄S₉; також повідомляється про наявність Cu₈SnS₆ [15], Cu₄Sn₃S₈ [16], Cu₃Sn₇S₁₆ [17]. Найбільш досліджена Cu₂SnS₃, одним із основних застосувань якої є сонячні елементи, завдяки високому коефіцієнту поглинання (105 см⁻¹); термоелектричні пристрой на її основі мають високі коефіцієнти потужності та низьку тепlopровідність [18]; також вона демонструє сильне випромінювання світла у видимому діапазоні, що робить її потенційним кандидатом для світлодіодів та інших оптоелектронних пристрой [19, 20]. Система Sb₂S₃ – SnS₂ [21, 22] характеризується утворенням однієї сполуки Sb₂SnS₅, яка майже не досліджена. Кристалохімічні характеристики наведених в літературі бінарних і тернарних сполук подано в табл.

Нешодавно в літературних джерелах [22, 33] подано взаємодії по перерізах Cu₂SnS₃ – Cu₃SbS₃ та Cu₂SnS₃ – Sb₂S₃, які є евтектичного типу. Ми в [34-36] також досліджували ці перерізи, CuSbS₂ – Cu₂SnS₃ та ізотермічний переріз за 500 К.

Отже, вивчення природи фізико-хімічних взаємодій у квазіпотрійній системі Cu₂S – Sb₂S₃ – SnS₂, де бінарні сульфіди плавляться конгруентно та можуть бути вихідними компонентами, є важливим завданням, оскільки сприятиме отриманню нових матеріалів для оптики й оптоелектроніки.

Методика експерименту

Для дослідження фазових рівноваг у квазіпотрійній системі Cu₂S – Sb₂S₃ – SnS₂ було синтезовано близько 70 сплавів. Синтез проводили з елементарних компонентів високого ступеня чистоти (Cu (99,99 мас. %); Sn (99,999 мас. %); Sb (99,998 мас. %); S (99,997 мас. %)) у вакуумованих до 0,13 Па та запаяніх кварцових ампулах. Режим синтезу: нагрівання до температури 670 К, витримка впродовж доби; наступне нагрівання до максимальної – 1170 К. Після 6 год витримки температуру поступово понижували до 500 К, за якої проводили відпалювання зразків протягом 500 год, далі сплави охолоджували в режимі виключеної печі. Ідентифікацію відомих сполук і дослідження сплавів квазіпотрійної системи виконували методами диференційно-термічного (ДТА) (установка, яка складається з печі з регульованим нагрівом «Термодент-03» фірми НТФ Прогрет, блоку підсилення сигналу термопари (Pt/Pt-Rh термопара, нагрівання зі швидкістю 10°C/хв, процес охолодження інерційний)), рентгенівського фазового (РФА) (дифрактометр ДРОН 4-13, CuK_α-випромінювання) та мікроструктурного (МСА) окремих зразків (мікротвердометр Leica VMHT Auto з максимальним збільшенням ×3811) аналізів.

Кристалографічні характеристики бінарних і тернарних сполук

Table

Crystallographic characteristics of binary and ternary compounds

Сполука	α -Cu ₂ S	β -Cu ₂ S	γ -Cu ₂ S	Sb ₂ S ₃	α -SnS ₂	β -SnS ₂
T _{пл} , К		1403 [23]		823 [4]		1143 [7]
Просторова група	<i>P</i> 2 ₁ / <i>c</i>	<i>P</i> 6 ₃ / <i>mmc</i>	<i>Fm</i> -3 <i>m</i>	<i>Pnma</i>	<i>P</i> -3 <i>m</i> <i>l</i>	<i>P</i> 6 ₃ <i>mc</i>
Параметри гратки, Å	<i>a</i> =15.246; <i>b</i> =11.884; <i>c</i> =13.494; β =116.35°	<i>a</i> =6.34	<i>a</i> =5.582	<i>a</i> =11.311; <i>b</i> =3.836; <i>c</i> =11.229	<i>a</i> =3.646; <i>c</i> =5.869	<i>a</i> =3.645; <i>c</i> =11.802
Література		[23]		[24]		[25, 26]
Сполука	Cu ₃ SbS ₃	CuSbS ₂	Cu ₂ SnS ₃	Cu ₄ SnS ₄	Cu ₄ Sn ₇ S ₁₆	
T _{пл} , К	885 [27], (α >493 K; β -264–493K; γ <263 K)	825 [27]	1123 [28]	1083 [28]	...	
Просторова група	<i>I</i> -43 <i>m</i> (<i>Pnma</i>) [<i>P</i> 2 ₁ 2 ₁ 2 ₁]	<i>Pnma</i>	<i>I</i> -42 <i>m</i>	<i>Cc</i>	<i>Pnma</i>	<i>R</i> -3 <i>mH</i>
Параметри гратки, Å	<i>a</i> =10.300 (<i>a</i> =7.808; <i>b</i> =10.252; <i>c</i> =6.587;) [<i>a</i> =7.884; <i>b</i> =10.221; <i>c</i> =6.624;]	<i>a</i> =6.008; <i>b</i> =3.784; <i>c</i> =14.456	<i>a</i> =5.413; <i>c</i> =10.824	<i>a</i> =6.653; <i>b</i> =11.537; <i>c</i> =6.665; β =109,39°	<i>a</i> =13.558; <i>b</i> =7.681; <i>c</i> =6.412	<i>a</i> =7.372; <i>c</i> =36.010
Література	[29]	[30]	[17]	[31]	[32]	[17]

Результати та обговорення

Експериментально ідентифіковано в квазіпотрійній системі Cu₂S – Sb₂S₃ – SnS₂ тернарні сполуки Cu₃SbS₃, CuSbS₂, Cu₄SnS₄, Cu₂Sn₄S₉, а існування CuSb₅S₈, Cu₈SnS₆, Cu₄Sn₃S₈, Cu₄Sn₇S₁₆, про які повідомляють літературні джерела [10, 15, 16, 17], не підтверджено. На основі сполук Cu₂S, Sb₂S₃, SnS₂, Cu₃SbS₃, Cu₄SnS₄, Cu₂SnS₃, Cu₂Sn₄S₉ виявлено тверді розчини α , β , γ , δ , ε , ζ , η , відповідно.

Літературні дані [21, 22] щодо фазової діаграми та наявності сполуки Sb₂SnS₅ в системі Sb₂S₃ – SnS₂ здебільшого узгоджуються з експериментальними. Аналіз порошокограм синтезованих зразків ускладнюється тим, що рефлекс фази SnS₂ дуже інтенсивний. Тому для виявлення потрійної сполуки аналізували дифрактограми в межах 20=18–90 град. Крім того, результати ДТА дають незначну річницю температур (~30 град) по обидві сторони від складу 50 мол. % Sb₂S₃ – 50 мол. % SnS₂, що відповідає потрійній сполуці Sb₂SnS₅. Під час дослідження зразків у межах підсистеми Sb₂S₃ – Cu₂Sn₄S₉ – SnS₂ з'ясували, що температури, які відповідають потрійному перитектичному процесу за участю Sb₂SnS₅ також вищі від температури потрійного евтектичного процесу, що поєднує кристалізацію Sb₂S₃, Sb₂SnS₅ та CuSbS₂. Зіставлення дифрактограм сполук Sb₂S₃, SnS₂ і синтезованих зразків вия-

вило, що система основних рефлексів складу Sb_2SnS_5 (50 мол. % Sb_2S_3 / 50 мол. % SnS_2) відрізняється від вихідних Sb_2S_3 та SnS_2 . Решта зразків досліджуваного квазібінарного перерізу є двофазовими. Отже, зазначений сплав Sb_2SnS_5 є індивідуальною сполукою, хоча її дифрактограма не дуже якісна. Побудована Т-х діаграма фазових рівноваг перерізу $Sb_2S_3 - SnS_2$ за результатами досліджень 9 сплавів зображена на рис. 1.

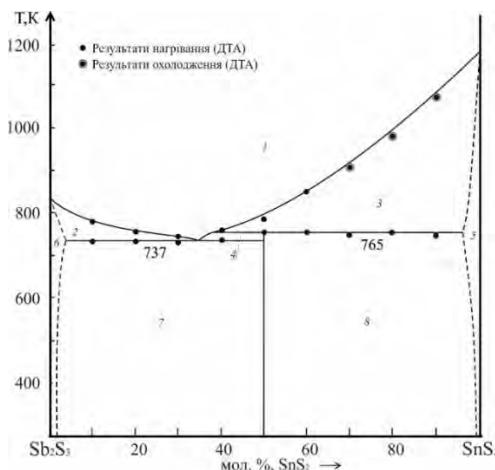


Рис. 1. Діаграма стану системи $Sb_2S_3 - SnS_2$ (1 – L; 2 – L+ β ; 3 – L+ γ ; 4 – L+ Sb_2SnS_5 ; 5 – γ ; 6 – β ; 7 – $\beta+Sb_2SnS_5$; 8 – $Sb_2SnS_5+\gamma$).

Fig. 1. The phase diagram of the $Sb_2S_3 - SnS_2$ system (1 – L; 2 – L+ β ; 3 – L+ γ ; 4 – L+ Sb_2SnS_5 ; 5 – γ ; 6 – β ; 7 – $\beta+Sb_2SnS_5$; 8 – $Sb_2SnS_5+\gamma$).

Тернарна сполука складу Sb_2SnS_5 утворюється інконгруентно за 765 К ($L + \gamma \leftrightarrow Sb_2SnS_5$). Евтектика плавиться за 737 К, її склад відповідає 65 мол. % Sb_2S_3 ($L \leftrightarrow \beta + Sb_2SnS_5$), що незначно відрізняється від результатів [21, 22].

Система $Cu_3SbS_3 - Cu_2SnS_3$ (рис. 2) належить до евтектичного типу з граничними твердими розчинами на основі вихідних компонентів $L \leftrightarrow \delta' + \zeta$. Для сполуки Cu_3SbS_3 зафіковано поліморфне перетворення: $BTM-Cu_3SbS_3(\delta') \leftrightarrow HTM-Cu_3SbS_3(\delta)$ за 633 К. Евтектоїдний процес $\delta' \leftrightarrow \delta + \zeta$ відбувається за 592 К. Кріві первинних кристалізацій твердих розчинів на основі $BTM-Cu_3SbS_3(\delta')$ і $Cu_2SnS_3(\zeta)$ перетинаються в евтектичній точці з координатами 866 К, 20 мол. % Cu_2SnS_3 , які значно відрізняються від координат, що наведені в праці [33] (780 К, 25 мол. % Cu_2SnS_3). За температури евтектичного процесу область гомогенності на основі Cu_3SbS_3 перебуває в межах 18 мол. %, на основі Cu_2SnS_3 – 12 мол. %. За температури 500 К на основі $HTM-Cu_3SbS_3$ виявлено існування твердого розчину протяжністю 0–10 мол. % Cu_2SnS_3 (δ -твёрдий розчин), який кристалізується в кубічній сингонії, що пов’язано з розмірним фактором. Розчинність на основі купруму(I) тіостанату Cu_2SnS_3 становить 7–8 мол. % (ζ -твёрдий розчин), що підтверджується даними РФА. Тверді розчини на основі Cu_2SnS_3 кристалізуються в тетрагональній сингонії

(ПГ I-42m). Зі збільшенням вмісту Cu₃SbS₃ параметри гратки збільшуються (рис. 3, *б*).

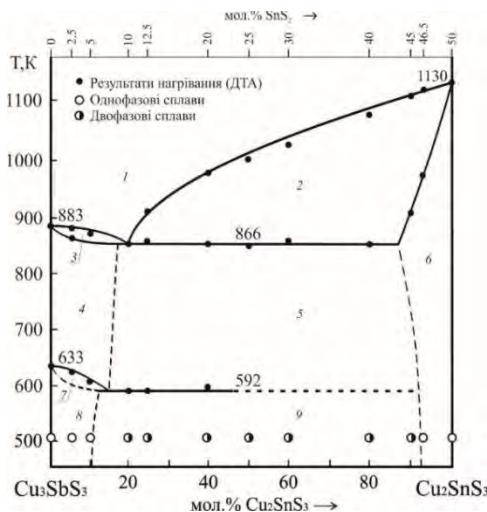


Рис. 2. Діаграма стану системи Cu₃SbS₃ – Cu₂SnS₃
(1 – L; 2 – L+ ζ ; 3 – L+ δ' ; 4 – δ' ; 5 – $\delta'+\zeta$; 6 – ζ ; 7 – $\delta'+\delta$; 8 – δ ; 9 – $\delta+\zeta$).

Fig. 2. The phase diagram of the Cu₃SbS₃ – Cu₂SnS₃ system
(1 – L; 2 – L+ ζ ; 3 – L+ δ' ; 4 – δ' ; 5 – $\delta'+\zeta$; 6 – ζ ; 7 – $\delta'+\delta$; 8 – δ ; 9 – $\delta+\zeta$).

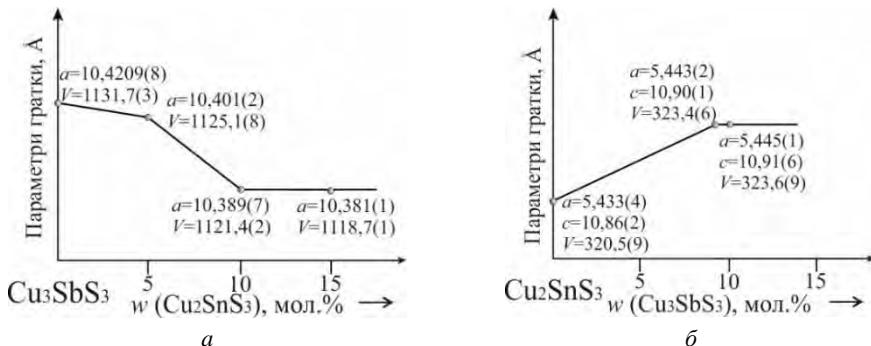


Рис. 3. Тверді розчини системи Cu₃SbS₃ – Cu₂SnS₃
(на схемах представлена зміна об'єму комірки).

Fig. 3. The solid solutions of the Cu₃SbS₃ – Cu₂SnS₃ system.

Система CuSbS₂ – Cu₂SnS₃ (рис. 4) характеризується евтектичною взаємодією L \leftrightarrow CuSbS₂+ ζ з координатами: 796 К та ~7 мол. % Cu₂SnS₃. За евтектичної температури Cu₂SnS₃ розчиняє приблизно 35 мол. % CuSbS₂ (ζ -твірдий розчин), зі зниженням температури концентраційна межа твердого розчину звужується і за 500 К становить ~12 мол. % (рис. 5, на схемі представлена зміна об'єму комірки). Розчинність на основі CuSbS₂ за температурі відпалювання не виявлена.

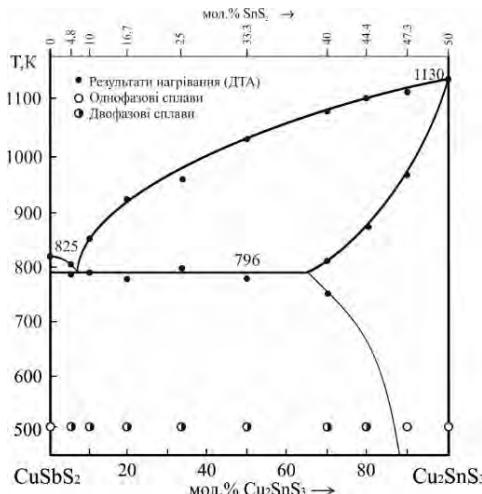


Рис. 4. Діаграма стану системи $\text{CuSbS}_2 - \text{Cu}_2\text{SnS}_3$ (1 – L; 2 – L+ ξ ; 3 – L+ CuSbS_2 ; 4 – ξ ; 5 – $\text{CuSbS}_2+\xi$).

Fig. 4. The phase diagram of the $\text{CuSbS}_2 - \text{Cu}_2\text{SnS}_3$ system.

Діаграма фазових рівноваг **перерізу** $\text{Sb}_2\text{S}_3 - \text{Cu}_2\text{SnS}_3$ (рис. 6) аналогічна до двох попередніх та є евтектичного типу. Ліквідус системи $\text{Sb}_2\text{S}_3 - \text{Cu}_2\text{SnS}_3$ містить дві криві первинної кристалізації твердих розчинів β і ζ , які перетинаються в точці, яка характеризується нонваріантною рівновагою $L \leftrightarrow \beta + \zeta$ та координатами: 12 мол. % Cu_2SnS_3 , 765 К. За цієї температури розчинність на основі Sb_2S_3 та Cu_2SnS_3 становить 8 та 16 мол. %, відповідно, і зменшується зі зниженням температури. На основі Cu_2SnS_3 за температури 500 К виявлено існування твердого розчину в межах 0–9 мол. % Sb_2S_3 , а на основі Sb_2S_3 – 5 мол. % Cu_2SnS_3 . Згідно з [22] твердий розчин на основі стибій (ІІІ) сульфіду має протяжність від 0 до 12 мол. % Cu_2SnS_3 . Проте ми з'ясували, що періоди елементарної комірки від складу 10 мол. % Cu_2SnS_3 не змінюються (рис. 7, на схемі представлена зміна об'єму комірки). За 500 К в рівновазі перебувають $\beta\text{-Sb}_2\text{S}_3$ (ПГ $Pnma$) та $\zeta\text{-Cu}_2\text{SnS}_3$ (ПГ $I-42m$). Координати евтектичного процесу незначно відрізняються від результатів праці [22] (30 мол. % Cu_2SnS_3 , 750 К).

Переріз $\text{Cu}_3\text{SbS}_3 - \text{Cu}_4\text{SnS}_4$ – неквазібінарний, оскільки Cu_4SnS_4 утворюються твердофазово, однак у підсолідусній області це двофазова рівновага. Діаграма стану перерізу $\text{Cu}_3\text{SbS}_3 - \text{Cu}_4\text{SnS}_4$ зображена на рис. 8. Ліквідус складається з трьох кривих кристалізації δ' - ϵ - ζ -твердих розчинів на основі сполук Cu_3SbS_3 , Cu_4SnS_4 та Cu_2SnS_3 , відповідно. Позаяк різниця температур ліквідусу, евтектичного ($L \leftrightarrow \alpha'' + \xi$) та твердофазового перитектоїдного ($\alpha'' + \xi \leftrightarrow \epsilon$ при 1083 К) процесів становить не більше 10 град між кожним, то після завершення перитектоїдного процесу, що починається на обмежуючій стороні $\text{Cu}_2\text{S} - \text{SnS}_2$, на цьому перетині у складі близько 80 мол. % Cu_4SnS_4 розпочинається первинна кристалізація Cu_4SnS_4 , яка завершується евтектичною взаємодією за 843 К ($L \leftrightarrow \delta' + \epsilon$). Евтектоїдний процес

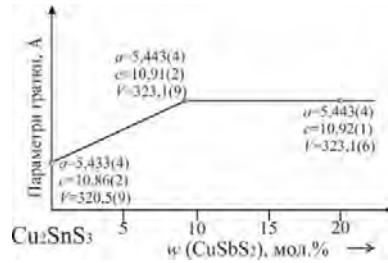


Рис. 5. Тверді розчини системи $\text{CuSbS}_2 - \text{Cu}_2\text{SnS}_3$.

Fig. 5. The solid solutions of the $\text{CuSbS}_2 - \text{Cu}_2\text{SnS}_3$ system.

$\delta' \leftrightarrow \delta + \epsilon$ за 595 К пов'язаний із поліморфним перетворенням сполуки Cu₃SbS₃; в підсолідусній області існує двофазова рівновага між δ -Cu₃SbS₃ (ПГ I-43m) і ϵ -Cu₄SnS₄ (ПГ Pnma). Розчинність на основі Cu₃SbS₃ становить ~10 мол. %, а на основі Cu₄SnS₄ близько 5 мол. %.

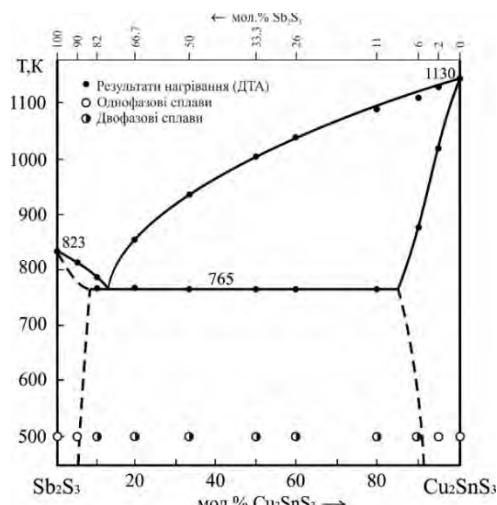


Рис. 6. Діаграма стану системи Sb₂S₃ – Cu₂SnS₃ (1 – L; 2 – L+ ζ ; 3 – L+ β ; 4 – β ; 5 – ζ ; 6 – $\beta+\zeta$).

Fig. 6. The phase diagram of the Sb₂S₃ – Cu₂SnS₃ system.

Переріз Sb₂S₃ – Cu₂Sn₄S₉ – неквазібінарний; проте в підсолідусній області всі синтезовані сплави двофазові. Взаємодія між Sb₂S₃ та Cu₂Sn₄S₉ аналогічна до попереднього перерізу (рис. 9).

Однак ліквідус зі сторони Cu₂Sn₄S₉ розпочинається кристалізацією відразу двох фаз, позаяк виходить з бінарної евтектики між Cu₂SnS₃ та SnS₂. Область первинної кристалізації тернарного сульфіду по перерізу значно менша через різницю у 181 град між евтектичним (L \leftrightarrow $\zeta + \gamma$) та перитектоїдним ($\zeta + \gamma \leftrightarrow \eta$ за 943 К) процесами та перебуває в межах 6–12 мол. % Cu₂Sn₄S₉ і завершується евтектичним процесом L \leftrightarrow $\beta + \eta$ за 762 К. Тобто, переріз частково квазібінарний і поводиться як подвійна система у всьому концентраційному інтервалі нижче евтектичної температури (підсолідусна частина).

Переріз Sb₂SnS₅ – Cu₂Sn₄S₉ – неквазібінарний, проте в підсолідусній області між Sb₂SnS₅ та Cu₂Sn₄S₉ існує двофазова рівновага (рис. 10). Він об'єднує перитектоїдний $\xi + \gamma \leftrightarrow \eta$ і перитектичний L + $\gamma \leftrightarrow$ Sb₂SnS₅ процеси з обмежуючих сторін Cu₂S – SnS₂ та Sb₂S₃ – SnS₂, відповідно, які в цій квазіпотрійній системі призводять до перебігу чотирифазового перитектичного процесу L + $\gamma \leftrightarrow$ Sb₂SnS₅ + η за 757 К та двофазовості усіх сплавів між Sb₂SnS₅ і Cu₂Sn₄S₉ (ПГ R-3m) за температури відпалювання (500 К), крім вихідних компонентів. Горизонтальна лінія за 943 К відповідає чотирифазовому перитектичному процесу L + $\xi + \gamma \leftrightarrow \eta$.

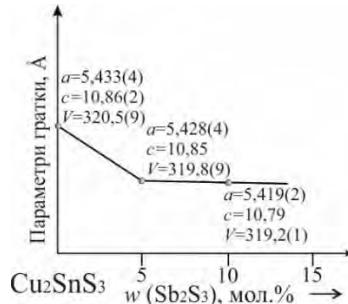


Рис. 7. Тверді розчини системи Sb₂S₃ – Cu₂SnS₃.

Fig. 7. The solid solutions of the Sb₂S₃ – Cu₂SnS₃ system.

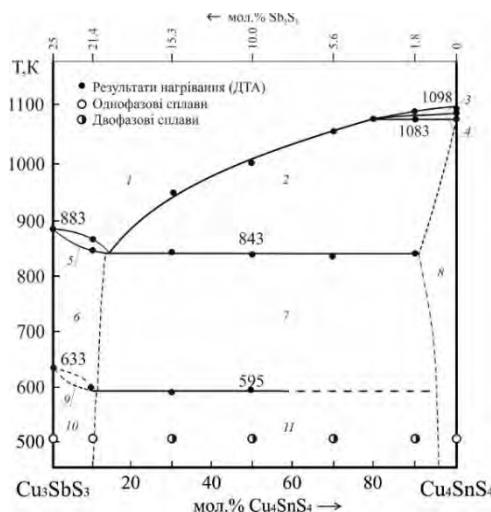


Рис. 8. Діаграма стану системи Cu₃SbS₃ – Cu₄SnS₄
(1 – L; 2 – L+ε; 3 – L+α; 4 – L+ζ+α; 5 – L+δ'; 6 – δ'; 7 – δ'+ε; 8 – ε; 9 – δ; 10 – δ'+δ; 11 – δ+ε).

Fig. 8. The phase diagram of the Cu₃SbS₃ – Cu₄SnS₄ system
(1 – L; 2 – L+ε; 3 – L+α; 4 – L+ζ+α; 5 – L+δ'; 6 – δ'; 7 – δ'+ε; 8 – ε; 9 – δ; 10 – δ'+δ; 11 – δ+ε).

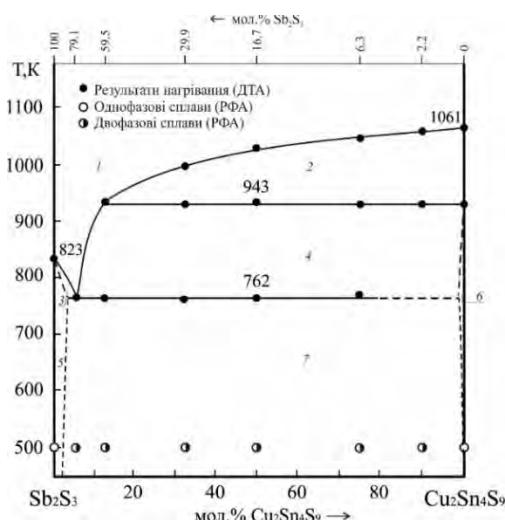


Рис. 9. Діаграма стану системи Sb₂S₃ – Cu₂Sn₄S₉
(1 – L; 2 – L+ζ+γ; 3 – L+β; 4 – L+η; 5 – β; 6 – η; 7 – β+η).

Fig. 9. The phase diagram of the Sb₂S₃ – Cu₂Sn₄S₉ system
(1 – L; 2 – L+ζ+γ; 3 – L+β; 4 – L+η; 5 – β; 6 – η; 7 – β+η).

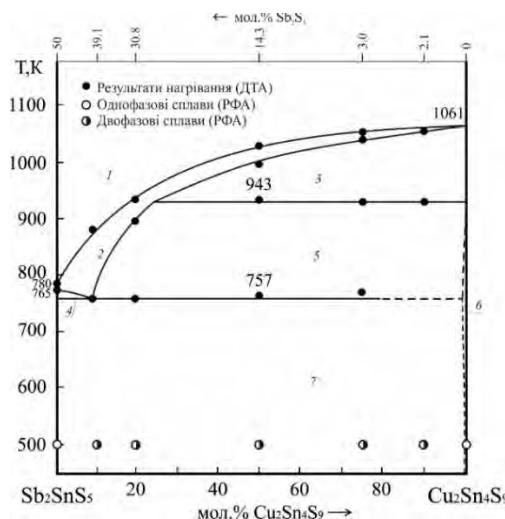


Рис. 10. Діаграма стану системи Sb₂SnS₅ – Cu₂Sn₄S₉ (1 – L; 2 – L+γ; 3 – L+ζ+γ; 4 – L+Sb₂SnS₅+η; 5 – L+η; 6 – η; 7 – Sb₂SnS₅+η).

Fig. 10. The phase diagram of the Sb₂SnS₅ – Cu₂Sn₄S₉ system (1 – L; 2 – L+γ; 3 – L+ζ+γ; 4 – L+Sb₂SnS₅+η; 5 – L+η; 6 – η; 7 – Sb₂SnS₅+η).

Ізотермічний переріз системи Cu₂S – Sb₂S₃ – SnS₂ за температури 500 К зображеній на рис. 11, де твердий розчин на основі сполуки Cu₃SbS₃ становить більше 10 мол. % Cu₂SnS₃, а розчинність на основі сполуки Cu₂SnS₃ сягає 7–8 мол. %. Між бінарними та тернарними сполуками обмежуючих перерізів Cu₂S – Sb₂S₃, Cu₂S – SnS₂, Sb₂S₃ – SnS₂ виявлено 15 двофазових рівноваг, які розділяють площину концентраційного трикутника на 7 трифазових полів: α – δ – ε, δ – ε – ζ, CuSbS₂ – δ – ζ, β – CuSbS₂ – ζ, β – ζ – η, β – η – Sb₂SnS₅, Sb₂SnS₅ – η – γ. Сполука Cu₂SnS₃ перебуває у рівновазі з Cu₃SbS₃, CuSbS₂ та Sb₂S₃. Також ще три двофазові рівноваги дають неквазібінарні перерізи Cu₃SbS₃ – Cu₄Sn₄, Sb₂S₃ – Cu₂Sn₄S₉, Sb₂SnS₃ – Cu₂Sn₄S₉.

За результатами дослідження шести перерізів (трьох квазібінарних і трьох неквазібінарних), а також з урахуванням літературних даних по системах Cu₂S – Sb₂S₃, Cu₂S – SnS₂ та Sb₂S₃ – SnS₂, побудована **проекція поверхні ліквідусу квазіпотрійної системи Cu₂S – Sb₂S₃ – SnS₂** (рис. 12), на якій окреслено поля первинної кристалізації фаз, що розділені моноваріантними кривими та точками нонваріантних рівноваг. На рис. 12 зображено хімічні реакції, які відбуваються в нонваріантних точках цієї системи.

У системі Cu₂S – Sb₂S₃ – SnS₂ (рис. 11) є 21 крива моноваріантних рівноваг і 9 потрійних нонваріантних (3 перитектичних і 6 евтектичних) точок. Найбільше поле первинної кристалізації має сполука Cu₂SnS₃, за її участю відбуваються 2 на обмежуючій Cu₂S – SnS₂ та 9 всередині системи нонваріантних процеси. Потрійні сполуки, що утворюються твердофазово Cu₄Sn₄, Cu₂Sn₄S₉ виходять на поверхню в точках U₁ і U₂ та мають доволі значні поля первинної кристалізації. В точці U₃ завершується перитектичний процес за участю рідини, γ, Sb₂SnS₅ та η. Три квазі-

бінарні системи $\text{Cu}_3\text{SbS}_3 - \text{Cu}_2\text{SnS}_3$, $\text{CuSbS}_2 - \text{Cu}_2\text{SnS}_3$ та $\text{Sb}_2\text{S}_3 - \text{Cu}_2\text{SnS}_3$ тріангулюють досліджувану систему $\text{Cu}_2\text{S} - \text{Sb}_2\text{S}_3 - \text{SnS}_2$ на чотири підсистеми.

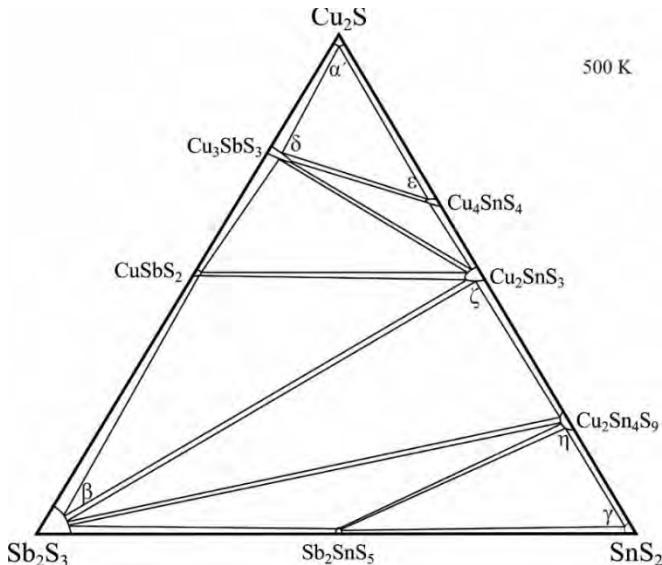


Рис. 11. Ізотермічний переріз системи $\text{Cu}_2\text{S} - \text{Sb}_2\text{S}_3 - \text{SnS}_2$ за 500 К.

Fig. 11. The isothermal section of the $\text{Cu}_2\text{S} - \text{Sb}_2\text{S}_3 - \text{SnS}_2$ system at 500 K.

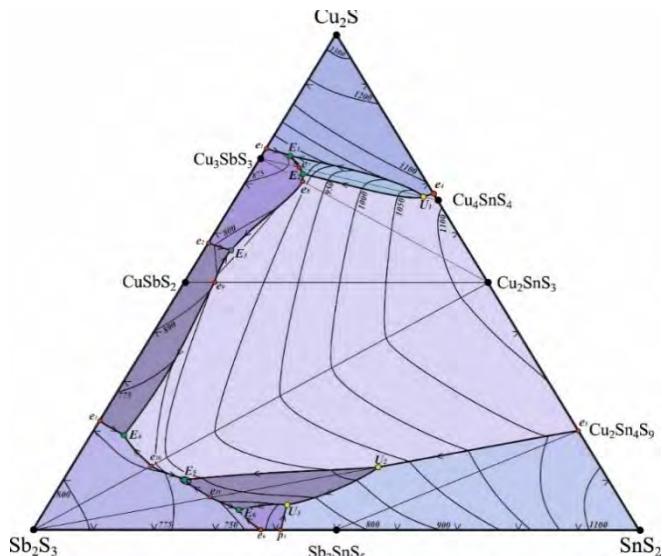


Рис. 12. Проекція поверхні ліквідусу системи $\text{Cu}_2\text{S} - \text{Sb}_2\text{S}_3 - \text{SnS}_2$.

Fig. 12. The liquidus surface projection of the $\text{Cu}_2\text{S} - \text{Sb}_2\text{S}_3 - \text{SnS}_2$ system.

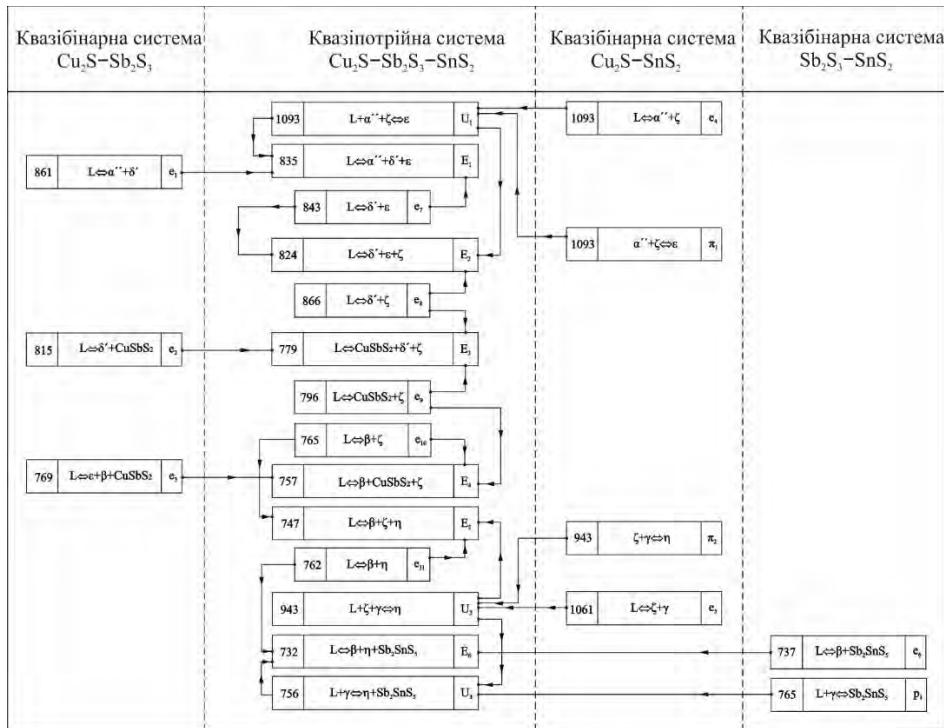


Рис. 13. Нонваріантні процеси в квазіпотрійній системі.

Fig.13. The scheme of the invariant process of the quasi-ternary system.

Крім зазначених трьох перитектичних процесів ($U_1 - U_3$), у системі відбувається шість евтектичних потрійних нонваріантних процесі ($E_1 - E_6$), що пов'язані з усіма тернарними сполуками обмежуючих систем, температури та склади яких зображені на схемі (рис. 13).

Висновки

Досліджено фізико-хімічні взаємодії у квазіпотрійній системі Cu₂S – Sb₂S₃ – SnS₂. Побудовано 6 політермічних перерізів та ізотермічний переріз за температури 500 К. Три перерізи: Cu₃SbS₃ – Cu₂SnS₃, CuSbS₂ – Cu₂SnS₃, Sb₂S₃ – Cu₂SnS₃ квазібінарні евтектичного типу поділяють квазіпотрійну систему на 4 підсистеми. Експериментально з'ясовано, що температура фазового переходу $\alpha \leftrightarrow \beta$ для Cu₃SbS₃ становить 633 К, що відрізняється від зазначеної у праці [29]. У квазібінарних системах існують обмежені тверді розчини на основі сполук Cu₃SbS₃ та Cu₂SnS₃, що є важливим для отримання нових матеріалів на їхній основі. Окреслено поля первинної кристалізації усіх бінарних і тернарних фаз.

ЛІТЕРАТУРА

1. *Madelung O., Rössler U., Schulz M.* Copper sulfides (Cu_2S , $\text{Cu}_{(2-x)}\text{S}$) crystal structure, lattice parameters. Landolt-Börnstein – Group III Condensed Matter. Vol. 41C. P. 1–5. (https://doi.org/10.1007/10681727_70).
2. *Riabtsev S.V., Zavrazhnov A.Yu., Berezin S.S., Rodyvylov S.V., Turyshchev S.Yu., Domashewskaia E.P.* Obtaining and characterisation of film samples of Cu_2S . Journal medium condensation and interphase boundaries. 2016. T. 18 (4). P. 545–549 (in Russian).
3. *Nieroda P., Leszczyński J., Mikula A., Mars K., Kruszewski M., Koleżyński A.* Thermoelectric properties of Cu_2S obtained by high temperature synthesis and sintered by IHP method. Ceram. Int. 2020. Vol. 46(16). P. 25460–25466. (<https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.07.016>).
4. *Tesfaye F., Taskinen P.* Thermodynamics and Phase Equilibria in the (Ni, Cu, Zn)-(As, Sb, Bi)-S Systems at Elevated Temperatures (300 – 900°C). Aalto University Publications in Materials Science and Engineering. 2010. P. 3. (<https://doi.org/10.13140/2.1.4901.2803>).
5. *Srikanth S., Suriyanarayanan N., Prabahar S., Balasubramanian V., Kathirvel D.* Structural and Optical Properties of Chemical bath Deposited Sb_2S_3 thin films. Adv. Appl. Sci. Res. 2011. Vol. 2(1). P. 95–104.
6. *Lan C., Liang G., Lan H., Peng H., Su Z., Zhang D., Fan P.* Microstructural and optical properties of Sb_2S_3 film thermally evaporated from antimony pentasulfide and efficient planar solar cells. Phys. Status Solidi RRL. 2018. Vol. 12(6). P. 1800025. (<https://doi.org/10.1002/pssr.201800025>)
7. *Bletskan D.I.* Phase equilibrium in binary Systems $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}}$: Part. III Systems Sn-Chalcogenides. ChemInform. 2006. Vol. 37(30). P. 61–69. (<https://doi.org/10.1002/chin.200630244>).
8. *Shi C., Yang P., Yao M., Dai X., Chen Z.* Preparation of SnS_2 thin films by close-spaced sublimation at different source temperatures. Thin Solid Films. 2013. Vol. 534. P. 28–31. (<https://doi.org/10.1016/j.tsf.2013.01.072>).
9. *Babanly N.B.* Phase equilibria and thermodynamic properties of the Cu–Ge(Sb)–S system. Abstract of dissertation. Baku, 1991. 23 pp. (in Russian).
10. *Babanly M.B., Yusibov Y.A., Abishev V.T.* Ternary Chalcogenides Based on Copper and Silver. Baku: BSU Publisher, 1993. 341 pp.
11. *Go-Eun Lee, Il-Ho Kim.* Skinnerite Cu_3SbS_3 : Solid-State Synthesis and Thermoelectric Properties. Korean J. Met. Mater. 2022. Vol. 60(6). P. 455–462. (<https://doi.org/10.3365/KJMM.2022.60.6.455>).
12. *Baoli Du, Ruizhi Zhang, Ming Liu, Kan Chen, Hangfeng Zhang, Michael J. Reece.* Crystal structure and improved thermoelectric performance of iron stabilized cubic Cu_3SbS_3 compound. J. Mat. Chem. C. 2019. Vol. 7. P. 394–404. (<https://doi.org/10.1039/C8TC05301D>)
13. *Rabhi A., Kanzari M., Rezig B.* Optical and structural properties of CuSbS_2 thin films grown by thermal evaporation method. Thin Solid Films. 2009. Vol. 517(7). P. 2477–2480. (<https://doi.org/10.1016/j.tsf.2008.11.021>).
14. *Olekseyuk İ.D., Dudchak I.V., Piskach L.V.* Phase equilibria in the $\text{Cu}_2\text{S}-\text{ZnS}-\text{SnS}_2$ system. J. Alloys Comp. 2004. Vol. 368. P. 135–143. (<https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2003.08.084>).
15. *Zotova T.V., Karagodin Yu.* The Investigation of character of phase equilibria in the Cu – Ge(Sn) – S quasi-ternary system. Bulletin of scientific papers of microelectronics. M: MIET. 1976. P.174–181 (in Russian).
16. *Khanafer M., Rivet J., Flahaut J.* Étude du système $\text{Cu}_2\text{S}-\text{GeS}_2$. Surstructure du composé Cu_2GeS_3 . Transition de phases du composé Cu_8GeS_6 . Bull. de la Soc. Chim. de Franc. 1973. Vol. 3. P. 859–862.

17. Chen X., Sato A., Wada H., Nozakin M.M. Synthesis, Electrical conductivity and Crystal Stucture of Cu₄Sn₇S₁₆ and Stucture refinement of Cu₂SnS₃. J. Sol. State Chem. 1998. Vol. 139. P. 144–151. (<https://doi.org/10.1006/jssc.1998.7822>).
18. Ahluwalia G.K. Applications of Chalcogenides: S, Se, and Te. Switzerland: Springer, 2017. 474 pp. (<https://doi.org/10.1007/978-3-319-41190-3>).
19. Fiechter S., Martinez M., Schmidt G. et al. Phase relations and optical properties of semiconducting ternary sulfides in the system Cu–Sn–S. J. Phys. Chem. Solids. 2003. Vol. 64. P. 1859–1862. ([https://doi.org/10.1016/S00223697\(03\)00172-0](https://doi.org/10.1016/S00223697(03)00172-0)).
20. Guan H., Shen H., Gao C., He X. Structural and optical properties of Cu₂SnS₃ and Cu₄SnS₄ thin films by successine ionic layer adsorption and reaction. J. Mater. Sci. Mater. Electr. 2013. Vol. 24. P. 1490–1494. (<https://doi.org/10.1007/s10854-012-0960-x>).
21. Rustamov P.G. Phase diagram of the SnS₂–Sb₂S₃ system. Dokl. Akad. Nauk SSSR. 1987. Vol. 43(1). P. 42.
22. Mamedov Sh.G. The phase equalibria of the Cu₂SnS₃–Sb₂S₃ system. Bull. Tomsk Univ. Ser. Khim. 2020. Vol. 18. P. 18–26 (in Russian). (<https://doi.org/10.17223/24135542/18/2>).
23. Chakrabarti D.J., Laughlin D.E. The Cu–S (Copper–Sulfur) system. Bull. Alloy Phase Diagr. 1983. Vol. 4. P. 254–271. (<https://doi.org/10.1007/BF02868665>).
24. Bayliss P., Nowacki W. Refinement of the crystal structure of stibnite, Sb₂S₃. Z. Kristallogr. 1972. Vol. 135(3–4). P. 308–315. (<https://doi.org/10.1524/ZKRI.1972.135.3-4.308>).
25. Arora S.K., Patel D.H., Agarwal M.K. Microtopographical Characterization of Vapour-grown SnS₂ Single Crystals. Cryst. Res. Techn. 1993. Vol. 28(5). P. 623–627. (<https://doi.org/10.1002/crat.2170280509>).
26. Guenter J.R., Oswald H.R. Neue polytype Form von Zinn(IV)-sulfid. J. App. Crystall. 1989. Vol. 22. P. 622–623.
27. Ilyasheva N.A. Diagramma sostoyaniya sistemyi Cu₂S–Sb₂S₃. Neorg. mater. 1973. Vol. 9(10). P. 1677–1679. (in Russian).
28. Olekseyuk I.D., Dudchak I.V., Piskach L.V. Phase equilibria in the Cu₂S–ZnS–SnS₂ system. J. Alloys Compd. 2004. Vol. 368. P. 135–143. (<https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2003.08.084>).
29. Pfitzner A. Disorder of Cu⁺ in Cu₃SbS₃: structural investigations of the high- and low-temperature modification. Z. Kristallogr. 1998. Vol. 213. P. 228–236. (<https://doi.org/10.1524/zkri.1998.213.4.228>).
30. Hofmann W. Strukturelle und morphologische Zusammenhaenge bei Erzen vom Formelytyp ABC₂. Z. Kristallogr. 1933. Vol. 84(1). P. 177–203. (<https://doi.org/10.1524/zkri.1933.84.1.177>).
31. Alias M.F.A., Naji I.S., Taher B.Y., Al-Douri A.A.J. Synthesis Cu₂SnS₃ and Cu₃SnS₄ nanopowder and studing the composition, structural and morphological properties. J. Non-oxide Glass. 2016. Vol. 8(4). P. 93–97.
32. Jaulmes S., Rivet J., Laruelle P. Cuivre–étain–soufre Cu₄SnS₄. Acta Cryst. 1977. Vol. B33. P. 540–542. (<https://doi.org/10.1107/S0567740877004002>).
33. Mamedov Sh.G. The phase equalibria of the Cu₂SnS₃–Cu₃SbS₃ system. Bull. Tomsk' Univ. Ser. Khim. 2019. Vol. 15. P. 26–35 (in Russian).
34. Bereznuk O.P., Olekseyuk I.D., Mazurets I.I. The phase equalibria of the Cu₂S–SnS₂–As₂S₃ (Sb₂S₃) systems at 500 K. «Lvivski khimichni chytannia» – 2019: The Issue of scientific works, Lviv, 2019. P. 210 (in Ukrainian).
35. Bereznuk O.P., Alrikik M., Kohut Yu.M., Piskach L.V. The phase equalibria of the Cu(Ag)₂S–SnS₂–Sb₂S₃ systems. Problems Chem. Sustainable Dev. 2022. Vol. 4. P. 17–30 (in Ukrainian). (<https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-4-2>).
36. Bereznuk O.P., Alrikik M., Piskach L.V. Psysico-chemical properties of Al₃C^VX₃ in the Al₂S–C^V₂S₃–B^{IV}S₂, de Al^I=Cu, Ag; C^V=As, Sb; B^{IV}=Ge, Sn system. «Khimichni Karazinski chytannia – 2023». Kharkiv, 2023. P. 18–19 (in Ukrainian).

SUMMARY***Orsya BEREZNIUK, Oleksandr SMITIUKH, Ludmyla PISKACH*****THE Cu₂S–Sb₂S₃–SnS₂ SYSTEM**

*Lesya Ukrainska Volyn National University,
Voli Ave. 13, 43025 Lutsk, Ukraine
e-mail: smitiukh.oleksandr@vnu.edu.ua*

The samples of appropriate compositions were synthesized from high-purity elements in evacuated quartz containers. Phase composition of obtained alloys was investigated by XRD, DTA, and microstructure analysis. Powder diffraction patterns were recorded at a DRON 4-13 X-ray diffractometer (2θ step 0.05° , 2θ range 10 – 90°). Phase analysis realized in WinCSD software package. Differential thermal analysis was performed at a set-up consisting of a Proget ThermoMod-03 furnace and a thermocouple signal amplification unit (Pt/Pt-Rh thermocouple). The microstructure of specific samples was investigated using a Leica VMHT Auto microhardness tester, top amplification $\times 3811$. Seven vertical sections were studied. The formation of the ternary compound Sb₂SnS₃ was confirmed at the Sb₂S₃–SnS₂ section that melts incongruently at 756 K ($L + \gamma \leftrightarrow Sb_2SnS_3$). The coordinates of the eutectic process are 737 K and 65 mol.% Sb₂S₃. Three vertical sections of this system, Cu₃SbS₃–Cu₂SnS₃, CuSbS₂–Cu₄SnS₃, Sb₂S₃–Cu₂SnS₃, are quasi-binary of the eutectic type with the coordinates 20, ~7, 12 mol.% Cu₂SnS₃ at 866, 796, 765 K, respectively. The sections Cu₃SbS₃–Cu₄SnS₄, Sb₂S₃–Cu₂Sn₄S₉, and Sb₂SnS₅–Cu₂Sn₄S₉ are quasi-binary only in the sub-solidus region. The compounds Cu₂S, Sb₂S₃, SnS₂, Cu₃SbS₃, Cu₄SnS₄, Cu₂Sn₄S₉ form limited solid solution ranges α , β , γ , δ , ε , ζ , η , respectively. The Cu₃SbS₃ compound has a polymorphous transformation at 633 K (HTM-Cu₃SbS₃ (δ') \leftrightarrow LTM-Cu₃SbS₃ (δ)). An isothermal section at 500 K was plotted featuring extensive solid solution ranges of Cu₃SbS₃ (>10 mol. %) and Cu₂SnS₃ (~7–8 mol. %). The binary and ternary compounds of the bounding sections form fifteen two-phase equilibria which divide the concentration triangle into seven three-phase fields, $\alpha - \delta - \varepsilon$, $\delta - \varepsilon - \zeta$, CuSbS₂ – $\delta - \zeta$, $\beta - \zeta - \eta$, $\beta - \eta - Sb_2SnS_5$, Sb₂SnS₅ – $\eta - \gamma$. The unit cell parameter of the Cu₃SbS₃ solid solution decreases at the Cu₃SbS₃–Cu₂SnS₃ section ($a=10.4209(8)$ – $10.389(1)$ Å), and those of the Cu₂SnS₃ solid solution slightly increase ($a=5.433(4)$ – $5.445(1)$ Å, $c=10.86(2)$ – $10.91(6)$ Å). The liquidus surface projection the quasi-ternary system Cu₂S – Sb₂S₃ – SnS₂ onto the concentration triangle is described by twenty-one monovariant curves, five binary and nine ternary invariant processes of which three are peritectic (U₁–U₃) and six are eutectic (E₁–E₆). Each compound has a field of primary crystallization, the largest of which belongs to Cu₂SnS₃. It is involved in two invariant processes at the bounding side Cu₂S – SnS₂, and three binary and six ternary processes within the system.

Keywords: quasi-binary system, eutectic, peritectic, solid solutions.

Стаття надійшла 10.06.2023.
Після доопрацювання 25.07.2023.
Прийнята до друку 29.09.2023.